/ <u>FUNDAM. FÍSICOS Y TE (2021)-216 11 16 2021</u> / <u>25 de enero - 31 de enero</u> / <u>Test segundo intento</u> Comenzado el viernes, 29 de enero de 2021, 19:52 Estado Finalizado Finalizado en viernes, 29 de enero de 2021, 20:28 **Tiempo** 36 minutos 47 segundos empleado **Calificación 145,00** de 330,00 (**44**%) Pregunta 1 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00 Se tiene una espira circular en el plano XY, centrada en el origen, por la cual circula una corriente I₀ en sentido antihorario. Por el centro de la espira pasa una carga negativa - q, moviéndose con velocidad vo en el sentido del eje x positivo. ¿Qué efecto produce la espira sobre la carga? a. Una fuerza en el sentido del eje X negativo $^{\bigcirc}\,$ b. Ninguno, ya que el campo es nulo en el centro de la espira o. Una fuerza en el sentido del eje Z negativo × Od. Una fuerza en el sentido del eje Y positivo La respuesta correcta es: Una fuerza en el sentido del eje Y positivo Pregunta **2** Correcta Puntúa 15,00 sobre 15,00 El campo eléctrico en el exterior de un conductor cargado tiene una dirección a. tangente a la superficie b. perpendicular a la superficie oc. que depende de la forma de la superficie del conductor

Página Principal / Mis cursos / GRADUADO-A EN ING.ª INFORMÁTICA-ADMINIST. Y DIRECC. EMPRESAS (2017) (216)

Puntúa 0,00 sobre 15,00	
¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?	
B	
a. si colocamos esta fuente en un circuito donde haya otras fuentes, el potencial en A siempre es mayor que el potencial en B	
○ b. si colocamos esta fuente en un circuito donde haya otras fuentes, el potencial en B siempre es mayor que el potencial en A	
C. si esta fuera la única fuente alimentando un circuito el potencial en B es siempre mayor que el potencial en A	
d. si esta fuera la única fuente alimentando un circuito el potencial en A es siempre mayor que el potencial en B	×
La respuesta correcta es:	
si esta fuera la única fuente alimentando un circuito el potencial en B es siempre mayor que el potencial en A	
Pregunta 4 Correcta	
Puntúa 20,00 sobre 20,00	
En un transistor MOSFET tipo p en conducción:	
a. El campo eléctrico que mueve los portadores va desde la fuente al drenador	~
○ b. El campo eléctrico que mueve los portadores va desde el drenador a la fuente	
C. No existe campo eléctrico entre fuente y drenador, sólo hay campo eléctrico en la estructura de puerta	
La respuesta correcta es: El campo eléctrico que mueve los portadores va desde la fuente al drenador	

Pregunta **3**Incorrecta

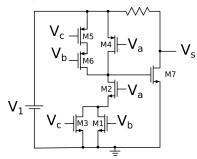
Pregunta 5	
Incorrecta	
Puntúa 0,00 sobre 20,00	
Para calcular el potencial en un punto creado por un cilindro infinito cargado:	
a. se puede elegir el origen de potencial en el infinito	
b. sólo se puede elegir una trayectoria en dirección del radio del cilindro para calcular el potencial	
© c. se puede elegir una trayectoria en la dirección del eje del cilindro para calcular el potencial	×
○ d. no se puede elegir el origen de potencial en el infinito	
La respuesta correcta es:	

no se puede elegir el origen de potencial en el infinito

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 25,00

En el circuito de la figura V1 =5V. Cuando Va=5V, Vb=0V y Vc=5V, el estado de cada uno de los transistores y la salida correspondiente es



- $^{\circ}$ a. M1=Lineal, M2=Lineal, M3=Corte, M4=Lineal, M5=Corte, M6=Lineal, M7=Lineal, Vs=0
- b. M1=Corte, M2=Lineal, M3=Lineal, M4=Corte, M5=Corte, M6=Lineal, M7=Corte, Vs=1
- c. M1=Corte, M2=Corte, M3=Lineal, M4=Lineal, M5=Corte, M6=Lineal, M7=Lineal, Vs=1

×

La respuesta correcta es:

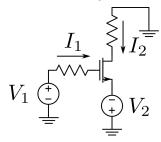
M1=Corte, M2=Lineal, M3=Lineal, M4=Corte, M5=Corte, M6=Lineal, M7=Corte, Vs=1

Pregunta 7	
Correcta Puntúa 25,00 sobre 25,00	
¿Qué ventaja tiene usar un circuito basado en un inversor con un n-MOSFET como carga frente a CMOS para diseñar circuitos lógicos?	
a. El circuito basado en el inversor con un n-MOSFET como carga es más barato que CMOS	~
○ b. El circuito basado en el inversor con un n-MOSFET como carga consume menos potencia que CMOS.	
o. El circuito basado en el inversor con un n-MOSFET como carga tiene siempre mejores márgenes de ruido que CMOS	
La respuesta correcta es: El circuito basado en el inversor con un n-MOSFET como carga es más barato que CMOS	
Pregunta 8	
Incorrecta	
Puntúa 0,00 sobre 10,00	
Una carga -Q se coloca en el interior de un globo con forma de Pikachu, y después se infla. Según el tamaño del globo va aumentando el número de líneas de campo que atraviesan la superficie del mismo :	
a. El interior de Pikachu es una jaula de Faraday, no pueden entrar ni salir líneas de campo	×
O b. Disminuye de manera inversamente proporcional al tamaño de Pikachu	
oc. Aumenta de forma directamente proporcional al tamaño de Pikachu	
O d. Permanece invariable	
La respuesta correcta es: Permanece invariable	

Puntúa 40,00 sobre 40,00 Una esfera de radio 6m está cargada con una densidad volumétrica de carga no uniforme de expresión 3*r (r es la distancia al centro de la esfera). El campo eléctrico a una distancia 3m es a. 162/epsilon_0 b. 32/epsilon_0 c. 108/epsilon_0 d. 80/epsilon_0 La respuesta correcta es: 108/epsilon_0	Pregunta 9
Una esfera de radio 6m está cargada con una densidad volumétrica de carga no uniforme de expresión 3*r (r es la distancia al centro de la esfera). El campo eléctrico a una distancia 3m es a. 162/epsilon_0 b. 32/epsilon_0 c. 108/epsilon_0 d. 80/epsilon_0 La respuesta correcta es: 108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntia 0,00 sobre 20,00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	Correcta
de la esfera). El campo eléctrico a una distancia 3m es a. 162/epsilon_0 b. 32/epsilon_0 c. 108/epsilon_0 d. 80/epsilon_0 La respuesta correcta es: 108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	Puntúa 40,00 sobre 40,00
de la esfera). El campo eléctrico a una distancia 3m es a. 162/epsilon_0 b. 32/epsilon_0 c. 108/epsilon_0 d. 80/epsilon_0 La respuesta correcta es: 108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	
de la esfera). El campo eléctrico a una distancia 3m es a. 162/epsilon_0 b. 32/epsilon_0 c. 108/epsilon_0 d. 80/epsilon_0 La respuesta correcta es: 108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	Una esfera de radio 6m está cargada con una densidad volumétrica de carga no uniforme de expresión 3*r (r es la distancia al centro
 b. 32/epsilon_0 c. 108/epsilon_0 d. 80/epsilon_0 La respuesta correcta es: 108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador ★	
 b. 32/epsilon_0 c. 108/epsilon_0 d. 80/epsilon_0 La respuesta correcta es: 108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador ★	
© c. 108/epsilon_0 □ d. 80/epsilon_0 La respuesta correcta es: 108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0.00 sobre 20,000 En un transistor MOSFET tipo p en corte: □ a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta □ b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	○ a. 162/epsilon_0
© c. 108/epsilon_0 □ d. 80/epsilon_0 La respuesta correcta es: 108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0.00 sobre 20,000 En un transistor MOSFET tipo p en corte: □ a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta □ b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	○ b. 32/epsilon_0
□ d. 80/epsilon_0 La respuesta correcta es: 108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0.00 sobre 20.00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: □ a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta □ b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador **	
La respuesta correcta es: 108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	
La respuesta correcta es: 108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	○ d. 80/epsilon 0
108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	
108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	
108/epsilon_0 Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00 En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	La respuesta correcta es:
En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	·
En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	
En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	
En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	Pregunta 10
En un transistor MOSFET tipo p en corte: a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	Incorrecta
 a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador 	Puntúa 0,00 sobre 20,00
 a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador 	
 a. Existe una capa de huecos debajo del óxido de puerta b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador 	En un transister MOSEET tipe n en corte:
b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	En un transistor MOSEET tipo p en corte.
b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	
b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	a. Evista una cana de huecos debaio del óvido de puerta
B. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	Existe una capa de nuecos debajo dei oxido de puerta
B. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador	
	 b. No existe en ningún caso un campo eléctrico entre fuente y drenador
C. Puede existir un campo eléctrico desde la fuente al drenador	, and the second of the second
C. Puede existir un campo eléctrico desde la fuente al drenador	
	C. Puede existir un campo eléctrico desde la fuente al drenador
La respuesta correcta es:	La respuesta correcta es:
Puede existir un campo eléctrico desde la fuente al drenador	Puede existir un campo eléctrico desde la fuente al drenador

Pregunta 11	
Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 15,00	
En un cilindro dieléctrico cargado	
a. el campo eléctrico en el exterior aumenta con la distancia	
b. la carga está distribuida solo en la superficie del cilindro	×
○ c. el campo eléctrico en el interior es cero	
O d. el campo eléctrico en el interior aumenta con la distancia	
La respuesta correcta es: el campo eléctrico en el interior aumenta con la distancia	
el campo electrico en el interior admenta con la distancia	
Pregunta 12	
Incorrecta	
Puntúa 0,00 sobre 20,00	
El uso de realimentación negativa en un circuito con Amplificador Operacional:	
a. hace oscilar al AO	
○ b. hace que el AO esté siempre saturado a la salida	
© C. hace posibles las operaciones lineales	×
La respuesta correcta es:	
hace oscilar al AO	

El transistor de la figura estará en corte si



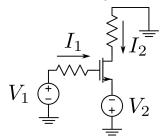
- a. (V1+V2)<VT
- b. (V1-I1R+V2)<VT
- c. _(V1-V2-I1R)<VT
- d. _(V1+V2)<VT

La respuesta correcta es:

(V1+V2)<VT

En el circuito de la figura se cumple que

×

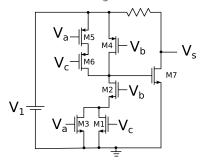


- oa. _{V2=VDS-I2R}
- b. V2=-VDS-I2R
- O c. V2=-VDS+I2R
- d. _{V2=VDS+I2R}

La respuesta correcta es:

V2=VDS+I2R

En el circuito de la figura



$$^{\scriptscriptstyle{()}}$$
 a. $V_s = V_b \cdot (V_a + V_c)$

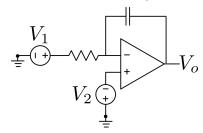
$$\circ$$
 b. $V_s = V_b + (V_a \cdot V_c)$

$$^{\circ}$$
 $^{\circ}V_s=\overline{V_b+(V_a\cdot V_c)}$

$$^{\scriptscriptstyle{\circ}}V_s = V_c \cdot (V_b + V_a)$$

La respuesta correcta es:
$$V_s = V_b \cdot (V_a + V_c)$$

En el circuito con AO de la figura:



×

- a. Vo=VCC si V2>V1
- b. Vo=VCC si 0>V1+V2
- c. Vo=VCC si V2+V1>0
- d. _{Vo=VCC} si V1>V2
- o e. Ninguna de las otras respuestas es correcta

La respuesta correcta es:

Vo=VCC si 0>V1+V2

→ Pdf ejercicio 16 relación 6

Ir a...

test problemas ►

Página Principal / Mis cursos / GRADUADO-A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS (2011) (297)

/ FUNDAMENTOS FÍSICOS (2021)-297_11_14_2021_/ 25 de enero - 31 de enero_/ Test segundo intento

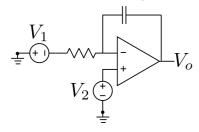
Comenzado el	viernes, 29 de enero de 2021, 19:50
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 29 de enero de 2021, 20:16
Tiempo	26 minutos 49 segundos
empleado	
Calificación	125,00 de 330,00 (38 %)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 20,00

En el circuito con AO de la figura:



○ a. _{Vo=VCC} si 0>V1+V2

○ b. Vo=VCC si V2+V1>0

o c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

○ d. _{Vo=VCC} si V2>V1

○ e. _{Vo=VCC} si V1>V2

La respuesta correcta es: Vo=VCC si V2+V1>0

Pregunta 2	
Incorrecta	
Puntúa 0,00 sobre 20,00	

El uso de realimentación negativa en un circuito con Amplificador Operacional:

- a. hace oscilar al AO
- O b. hace que el AO esté siempre saturado a la salida
- © c. hace posibles las operaciones lineales

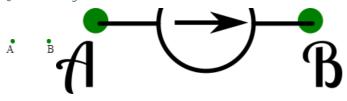
La respuesta correcta es:

hace oscilar al AO

Pregunta **3**Correcta

Puntúa 15,00 sobre 15,00

¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



- O a. si colocamos esta fuente en un circuito donde haya otras fuentes, el potencial en A siempre es mayor que el potencial en B
- 🔘 b. si esta fuera la única fuente alimentando un circuito el potencial en A es siempre mayor que el potencial en B
- © c. si esta fuera la única fuente alimentando un circuito el potencial en B es siempre mayor que el potencial en A
- O d. si colocamos esta fuente en un circuito donde haya otras fuentes, el potencial en B siempre es mayor que el potencial en A

La respuesta correcta es:

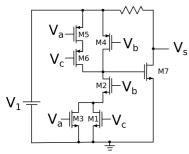
si esta fuera la única fuente alimentando un circuito el potencial en B es siempre mayor que el potencial en A

/2021	Test segundo intento: Revisión del intento	
Pregunta 4		
Incorrecta		
Puntúa 0,00 sobre 15,00		
El campo eléctrico en el exter	rior de un conductor cargado tiene una dirección	
a. que depende de la form	rma de la superficie del conductor	×
o b. perpendicular a la sup	perficie	
c. tangente a la superficie	e	
La respuesta correcta es: perp	pendicular a la superficie	
Pregunta 5		
Incorrecta		
Puntúa 0,00 sobre 15,00		
En una esfera dieléctrica carg	gada	
a. el campo eléctrico en e	el exterior es directamente proporcional a la distancia a la que se calcule	
 b. el campo eléctrico en o 	el interior es directamente proporcional a la distancia a la que se calcule	
c. toda la carga está distr		×
C. toda la carga esta distr	inbulda eri su superficie	•
d. el campo eléctrico en o	el interior es nulo	
La respuesta correcta es:		
· ·	rior es directamente proporcional a la distancia a la que se calcule	

Correcta

Puntúa 25,00 sobre 25,00

En el circuito de la figura



$$^{\scriptscriptstyle{\bigcirc}}$$
 a. $V_s=\overline{V_b+(V_a\cdot V_c)}$

$$^{\circ}$$
 b. $V_s = V_b + (V_a \cdot V_c)$

$$^{\circ}V_s = V_c \cdot (V_b + V_a)$$

$$^{\scriptscriptstyle{\scriptsize{\scriptsize{0}}}}$$
 d. $V_s = V_b \cdot (V_a + V_c)$

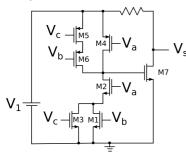
La respuesta correcta es:

$$V_s = V_b \cdot (V_a + V_c)$$

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 25,00

En el circuito de la figura V1 =5V. Cuando Va=0V, Vb=0V y Vc=5V, el estado de cada uno de los transistores y la salida correspondiente es:



- a. M1=Corte, M2=Corte, M3=Saturación, M4=Saturación, M5=Corte, M6=Saturación, M7=Saturación, Vs=0
- b. M1=Corte, M2=Corte, M3=Lineal, M4=Lineal, M5=Corte, M6=Lineal, M7=Lineal, Vs=0
- © C. M1=Corte, M2=Corte, M3=Lineal, M4=Corte, M5=Lineal, M6=Corte, M7=Lineal,Vs=Indeterminación
- Od. M1=Lineal, M2=Lineal, M3=Corte, M4=Corte, M5=Lineal, M6=Corte, M7=Corte, Vs=1

La respuesta correcta es:

M1=Corte, M2=Corte, M3=Lineal, M4=Lineal, M5=Corte, M6=Lineal, M7=Lineal, Vs=0

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 25,00 sobre 25,00

¿Qué ventaja/ventajas tiene usar la tecnología donde la carga es una resistencia frente a CMOS para diseñar circuitos lógicos?

- a. El circuito con resistencia como carga es más barato
- b. El circuito de la con resistencia como carga tiene mejores márgenes de ruido
- O c. El circuito con resistencia como carga ocupa menos espacio porque tiene menos elementos
- O d. El circuito con resistencia como carga consume menos potencia

La respuesta correcta es:

El circuito con resistencia como carga es más barato

2021	Test segundo intento: Revisión del intento
Pregunta 9	
Incorrecta	
Puntúa 0,00 sobre 10,00	
	en el interior de un globo con forma de Pikachu, y después se infla. Según el tamaño del globo va de líneas de campo que atraviesan la superficie del mismo :
a. El interior de Pika	chu es una jaula de Faraday, no pueden entrar ni salir líneas de campo
O b. Disminuye de ma	nera inversamente proporcional al tamaño de Pikachu
oc. Aumenta de form	a directamente proporcional al tamaño de Pikachu
O d. Permanece invari	able
La respuesta correcta es	
Permanece invariable	
Pregunta 10	
Incorrecta	
Puntúa 0,00 sobre 40,00	
	está cargada con una densidad volumétrica de carga no uniforme de expresión 3*r (r es la distancia al centro léctrico a una distancia 3m es
·	
a. 108/epsilon_0	
b. 32/epsilon_0	
c. 162/epsilon_0	×
d. 80/epsilon_0	
La respuesta correcta es	
108/epsilon_0	

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

Se tiene una espira circular en el plano XY, centrada en el origen, por la cual circula una corriente I_0 en sentido horario. Por el centro de la espira pasa una carga negativa - q, moviéndose con velocidad vo en el sentido del eje x positivo. ¿Qué efecto produce la espira sobre la carga?

- a. Una fuerza en el sentido del eje Z negativo
- igorup b. Ninguno, ya que el campo es nulo en el centro de la espira
- o. Una fuerza en el sentido del eje Y negativo
- O d. Una fuerza en el sentido del eje X positivo

La respuesta correcta es:

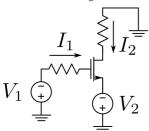
Una fuerza en el sentido del eje Y negativo

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 20,00

El transistor de la figura estará en corte si



- a. V1-V2-I1R<VT
- b. V1-V2<VT</p>
- o. V1+V2>VT
- d. V1+V2-I1R<VT</p>

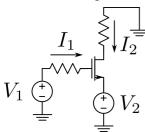
La respuesta correcta es:

V1+V2>VT

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En el circuito de la figura se cumple que



- a. V2=-VDS-I2R
- O b. V2=VDS-I2R
- O c. V2=VDS+I2R
- Od. _{V2=-VDS+I2R}

La respuesta correcta es:

V2=-VDS-I2R

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

En un transistor MOSFET tipo p en conducción:

- a. El campo eléctrico que mueve los portadores va desde el drenador a la fuente
- $^{\odot}~$ b. El campo eléctrico que mueve los portadores va desde la fuente al drenador
- C. No existe campo eléctrico entre fuente y drenador, sólo hay campo eléctrico en la estructura de puerta

La respuesta correcta es:

El campo eléctrico que mueve los portadores va desde la fuente al drenador

Pregunta 15 Incorrecta	
Puntúa 0,00 sobre 20,00	
El comportamiento de un MOSFET en conducción puede equipararse al de	
○ a. Una bobina	
○ b. Una resistencia	
○ c. Una fuente de alimentación	
[◎] d. Un condensador	×
La respuesta correcta es: Una resistencia	
Pregunta 16 Incorrecta	
Puntúa 0,00 sobre 20,00	
Para calcular el potencial en un punto creado por un plano infinito cargado:	
a. sólo se puede elegir una trayectoria en dirección perpendicular al plano cargado para calcular el potencial	
b. no se puede elegir el origen de potencial en el infinito	
C. se puede elegir una trayectoria con dirección contenida en el plano cargado para calcular el potencial	
 d. se puede elegir el origen de potencial en el infinito 	×
La respuesta correcta es: no se puede elegir el origen de potencial en el infinito	

▼ Vídeo Clase GA GIM 14 Enero 2021

Ir a..

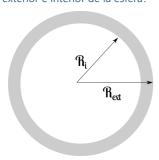
Test problemas ►

<u>Página Principal</u> / M	lis cursos / GRADUADO-A EN ING.ª INFORMÁTICA-ADMINIST. Y DIRECC. EMPRESAS (2017) (216)			
/ FUNDAM FÍSICO	S Y TE (2021)-216 11 16 2021 / 25 de enero - 31 de enero / Test segundo intento			
, <u>rondrani. Horeo</u>	<u> </u>			
	` 20 J J. 2024 40.52			
Estado	Comenzado el viernes, 29 de enero de 2021, 19:52 Estado Finalizado			
	viernes, 29 de enero de 2021, 20:31			
Tiempo				
empleado				
Calificación	125,00 de 330,00 (38 %)			
Pregunta 1				
Incorrecta				
Puntúa 0,00 sobre 25,00				
¿Qué ventaja tiene lógicos?	usar un circuito basado en un inversor con un n-MOSFET como carga frente a CMOS para diseñar circuitos			
logicos:				
a. El circuito ba	asado en el inversor con un n-MOSFET como carga es más barato que CMOS			
o b. El circuito ba	asado en el inversor con un n-MOSFET como carga tiene siempre mejores márgenes de ruido que CMOS			
c. El circuito ba	asado en el inversor con un n-MOSFET como carga consume menos potencia que CMOS.	×		
La respuesta correc	cta es:			
El circuito basado e	en el inversor con un n-MOSFET como carga es más barato que CMOS			
Pregunta 2				
Incorrecta				
Puntúa 0,00 sobre 20,00				
·				
Para calcular el pot	encial en un punto creado por un plano infinito cargado:			
O a. sála sa musa	de elegir una trayectoria en dirección perpendicular al plano cargado para calcular el potencial			
solo se pued	de elegir una trayectoria en dirección perpendicular al plano cargado para calcular el potencial			
O b. se puede ele	egir una trayectoria con dirección contenida en el plano cargado para calcular el potencial			
se paede en	agir una trayectoria con anección contenida en el piano cargado para carcarar el potenciar			
c. se puede ele	egir el origen de potencial en el infinito	×		
od. no se puede	e elegir el origen de potencial en el infinito			

no se puede elegir el origen de potencial en el infinito

Pregunta **3**Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 15,00

Sea una esfera conductora hueca en cuyo centro hay una carga puntual – Q ¿Qué sucede con los potenciales en las superficies exterior e interior de la esfera?



- a. El potencial en la superficie interna es el mayor
- O b. Los potenciales de ambas superficies son cero
- © C. Los potenciales de ambas superficies son iguales pero no cero

La respuesta correcta es:

El potencial en la superficie interna es el mayor

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

A la salida de un Amplificador Operacional:

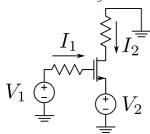
- a. La intensidad vale cero siempre
- $^{\circ}\,$ C. La intensidad siempre tiene sentido entrante al AO
- $^{\circ}\,$ d. La intensidad siempre tiene sentido saliente al AO

La respuesta correcta es:

El sentido de la intensidad depende de la relación entre V+ y V-

Pregunta 5	
Correcta	
Puntúa 20,00 sobre 20,00	

En el circuito de la figura se cumple que



а			
٠	V2=-\	√DS-	12R



O c. _{V2=-VDS+I2R}

Od. _{V2=VDS-I2R}

La respuesta correcta es:

V2=-VDS-I2R

Pregunta **6**Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 40,00

Una esfera de radio 4m está cargada con una densidad volumétrica de carga no uniforme de expresión 5*r (r es la distancia al centro de la esfera). El campo eléctrico a una distancia 2m es

- a. 162/epsilon_0
- ob. 80/epsilon_0
- c. 32/epsilon_0

od. 108/epsilon_0

La respuesta correcta es: 80/epsilon_0

Pregunta 7	
Incorrecta	
Puntúa 0,00 sobre 20,00	

Se tiene una espira circular en el plano XY, centrada en el origen, por la cual circula una corriente l_0 en sentido antihorario. Por el centro de la espira pasa una carga positiva +q, moviéndose con velocidad vo en el sentido del eje x positivo. ¿Qué efecto produce la espira sobre la carga?

a. Una fuerza en el sentido del eje Z positivo	×
○ b. Una fuerza en el sentido del eje Y negativo	
C. Ninguno, ya que el campo es nulo en el centro de la espira	

Od. Una fuerza en el sentido del eje X positivo

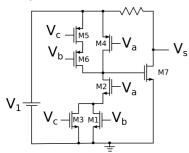
La respuesta correcta es:

Una fuerza en el sentido del eje Y negativo

Correcta

Puntúa 25,00 sobre 25,00

En el circuito de la figura V1 =5V. Cuando Va=0V, Vb=0V y Vc=5V, el estado de cada uno de los transistores y la salida correspondiente es:



- a. M1=Corte, M2=Corte, M3=Saturación, M4=Saturación, M5=Corte, M6=Saturación, M7=Saturación, Vs=0
- b. M1=Corte, M2=Corte, M3=Lineal, M4=Lineal, M5=Corte, M6=Lineal, M7=Lineal, Vs=0
- C. M1=Lineal, M2=Lineal, M3=Corte, M4=Corte, M5=Lineal, M6=Corte, M7=Corte, Vs=1
- Od. M1=Corte, M2=Corte, M3=Lineal, M4=Corte, M5=Lineal, M6=Corte, M7=Lineal, Vs=Indeterminación

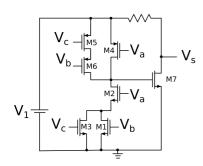
La respuesta correcta es:

M1=Corte, M2=Corte, M3=Lineal, M4=Lineal, M5=Corte, M6=Lineal, M7=Lineal, Vs=0

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 25,00

En el circuito de la figura:



$$^{\scriptscriptstyle{\bigcirc}}$$
 a. $V_s=\overline{V_a+(V_b\cdot V_c)}$

$$^{\circ}$$
 b. $V_s = V_a \cdot (V_b + V_c)$

$$^{\scriptscriptstyle{\circ}}$$
 c. $V_s=\overline{V_a\cdot (V_b+V_c)}$

$$^{\scriptscriptstyle{()}}$$
 d. $V_s = V_a + (V_b \cdot V_c)$

La respuesta correcta es:
$$V_s = V_a \cdot (V_b + V_c)$$

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 15,00

En un cilindro dieléctrico cargado

- a. el campo eléctrico en el exterior aumenta con la distancia
- b. el campo eléctrico en el interior es cero
- oc. el campo eléctrico en el interior aumenta con la distancia
- o d. la carga está distribuida solo en la superficie del cilindro

×

×

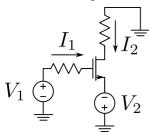
La respuesta correcta es:

el campo eléctrico en el interior aumenta con la distancia

Correcta

Puntúa 20,00 sobre 20,00

El transistor de la figura estará en corte si



- a. (V1-I1R+V2)<VT
- b. (V1+V2)<VT
- o. (V1-V2-I1R)<VT
- d. (V1+V2)<VT

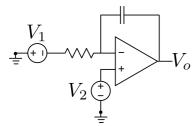
La respuesta correcta es:

(V1+V2)<VT

Incorrecta

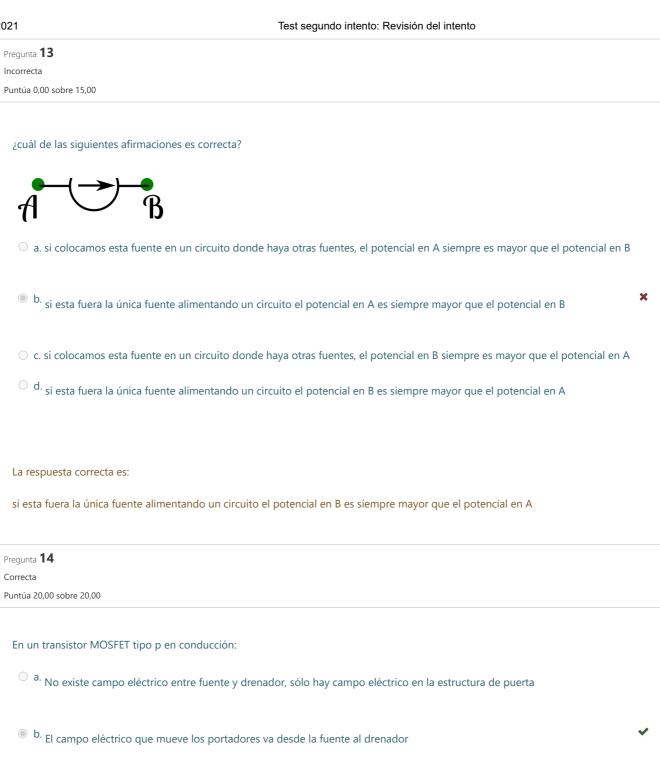
Puntúa 0,00 sobre 20,00

En el circuito con AO de la figura:



- a. Vo=VCC si V2+V1>0
- b. Vo=VCC si V2>V1
- C. Vo=VCC si V1>V2
- d. _{Vo=VCC} si 0>V1+V2
- o e. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

La respuesta correcta es: Vo=VCC si V2+V1>0



 $^{\circ}$ C. El campo eléctrico que mueve los portadores va desde el drenador a la fuente

La respuesta correcta es:

El campo eléctrico que mueve los portadores va desde la fuente al drenador

2021 Test segundo mento. Nevisión del mento	
Pregunta 15 Correcta	
Puntúa 20,00 sobre 20,00	
En un transistor MOSFET el principal modo de control de la corriente se realiza	
a. a través de la tensión de puerta	~
b. a través de la diferencia de potencial entre drenador y fuente	
C. a través del dopado del semiconductor en la fuente	
○ d. a través del dopado del semiconductor en el drenador	
La respuesta correcta es: a través de la tensión de puerta Pregunta 16 Incorrecta	
Puntúa 0,00 sobre 10,00	
Una carga +Q se coloca en el interior de un globo con forma de unicornio, y después se infla. Según el tamaño del globo va aumentando el número de líneas de campo que atraviesan la superficie del mismo :	
a. Aumentan proporcionalmente al tamaño del unicornio	×
O b. Ninguna, las líneas de campo rebotan en la piel del unicornio	
C. Disminuyen de manera inversamente proporcional al tamaño del unicornio	
d. Permanecen invariables	
La respuesta correcta es: Permanecen invariables	

•	Pdf	eje	rcicio	16	re	lación	6
---	-----	-----	--------	----	----	--------	---

Ir a...

test problemas ►